

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年12月24日(2009.12.24)

【公開番号】特開2007-184610(P2007-184610A)

【公開日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【年通号数】公開・登録公報2007-027

【出願番号】特願2006-355950(P2006-355950)

【国際特許分類】

H 01 L 29/786 (2006.01)

G 09 F 9/30 (2006.01)

G 02 F 1/1368 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 1 2 A

G 09 F 9/30 3 3 8

G 02 F 1/1368

H 01 L 29/78 6 1 8 B

G 09 F 9/30 3 3 9 Z

【手続補正書】

【提出日】平成21年11月4日(2009.11.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1方向に延長されて形成されたデータ線と、

前記第1方向と交差する第2方向に延長され形成されたゲート線と、

データ線と電気的に連結されたソース電極、ゲート線と電気

的に連結されたゲート電極、及び前記ゲート電極上に形成された半導体層を含むスイッチング素子と、

透明な酸窒化物で形成され、前記スイッチング素子と電気的に連結された画素電極と、
を含むことを特徴とする表示基板。

【請求項2】

前記透明な酸窒化物は、インジウム(I n)、錫(S n)、亜鉛(Z n)、アルミニウム(A l)及びガリウム(G a)よりなる群から選択された一つ以上を含有した酸窒化物であることを特徴とする請求項1に記載の表示基板。

【請求項3】

前記画素電極の下に形成された有機絶縁層をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の表示基板。

【請求項4】

前記画素電極は、

透明な酸窒化物で前記有機絶縁層上に形成された下部伝導層と、

透明な酸化物で前記下部伝導層上に形成された上部伝導層と、

を含むことを特徴とする請求項3に記載の表示基板。

【請求項5】

前記透明な酸化物は、インジウム(I n)、錫(S n)、亜鉛(Z n)、アルミニウム(A l)及びガリウム(G a)よりなる群から選択された一つ以上を含有した酸化物であ

ることを特徴とする請求項 4 に記載の表示基板。

【請求項 6】

前記ソース電極は、前記画素電極と同一層で形成され、前記データ線とコンタクトホールを通じて電気的に連結されていることを特徴とする請求項 1 に記載の表示基板。

【請求項 7】

さらにドレイン電極が、前記画素電極と一体形に形成されることを特徴とする請求項 6 に記載の表示基板。

【請求項 8】

前記半導体層上に形成されたストップ層をさらに含むことを特徴とする請求項 1 に記載の表示基板。

【請求項 9】

前記半導体層は、有機物質を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の表示基板。